ランダムスピン系の磁性:酸化物ガラスに見られる スピングラス転移

京都大学 大学院工学研究科

田中 勝久

Magnetism of random spin system : Spin glass transition observed in oxide glass

Katsuhisa Tanaka

Graduate School of Engineering, Kyoto University

1. はじめに

ランダムスピン系が示す典型的な磁気秩序の 一つにスピングラスがある。これは、文字通 り、磁性を担うスピンのガラス状態である。ス ピングラスは、常磁性金属(たとえば、Cuや Au)にわずかな量の磁性元素(たとえば、Mn やFe)が含まれる合金の結晶で実験的に見い だされて以来^{11,2}、奇妙な磁性体として主に物 理学者の興味を引き、実験と理論の両面から多 くの研究がなされてきた物質群である。これま で、物質そのものに実用的な磁性材料としての 価値はほとんど見いだされていないが、複雑な 磁気転移の挙動や磁気構造を中心に基礎的な観 点からは大いに注目されてきた。また、スピン グラスの理論が、脳の働きとも関連するニュー ラルネットワークの研究と情報処理への展開な

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂 TEL 075-383-2801 FAX 075-383-2420 E-mail:tanaka@dipole7.kuic.kyoto-u.ac.jp ど情報工学の理論として有効であることが明ら かにされ,最近では量子コンピューターへの展 開も図られるなど,他分野へ大きな影響を及ぼ している^{3).4)}。さらに,酸化物ガラスなどで観 察されるガラス転移は,ガラス状態の最も本質 的な現象であるにもかかわらず未解明な点が多 いが,スピンのガラス状態(スピングラス)の 研究はそのような一般的なガラス転移の理解に もヒントを与えてくれる可能性がある。

酸化物ガラスはイオンの配列に並進対称性が ないため、そこに含まれる磁性イオンの分布も 無秩序になり、その磁性がスピングラスと似寄 るであろうことは容易に想像できる。実際、酸 化物ガラスで観察される磁気転移とスピングラ ス転移との類似性は古くから指摘されてきた が⁵⁾⁻¹⁰⁾,結晶のスピングラスに対してなされて きたスピングラスを特徴づける測定や解析が、 酸化物ガラスにも適用され始めたのは比較的最 近である。筆者らは、さまざまな酸化物ガラス を対象に磁気的性質に関する研究を行ってき た¹¹⁾⁻¹⁸⁾。得られた結果の一部は解説として NEW GLASS 誌でも紹介している¹⁹⁾⁻²¹⁾。本稿では筆 者らの研究グループがこれまでに行った実験の 結果に基づいて,酸化物ガラスのスピングラス 転移に関わる現象の一端を紹介する。

2.酸化物ガラスが示すスピングラス転移

酸化物ガラスが示すスピングラス転移の一例 として,鉄リン酸塩ガラスの交流磁化率の実部 の温度依存性を図1に示す¹³⁾。ここに例示した ガラスでは鉄イオンは2価と3価の状態が共存 し、組成は30Fe₂O₃・15FeO・55P₂O₅ (mol%) と表される。交流磁化率は、3 Oe の振幅(非 常に小さい磁場であることに注意していただき たい)の交流磁場を印加し、周波数を0.3Hz から1000 Hz まで変えて、ゼロ磁場冷却過程で 測定したものである。8K付近に磁化率の極大 が見られ.極大の温度は周波数が高くなるほど 高温側にシフトしている。これらの温度で測定 時間スケールでのスピンの凍結が起こっている とみなせる。観察しているランダムスピン系が 磁気転移に向けて臨界減速 (critical slowing down)を起こすと考えてスピン凍結温度の周 波数依存性を定量的に解析した結果が図1の挿 入図である。スピン凍結のマクロな緩和時間τ と凍結温度 T_iとの関係は臨界発散を反映した



図1 30Fe₂O₃・15FeO・55P₂O₅ (mol%) ガラスの交 流磁化率の実部の温度依存性.挿入図は、スピ ン凍結温度と交流周波数との関係を式(1)に基 づいて解析した結果

式

$$\tau = \tau_0 \left(\frac{T_{\rm f} - T_{\rm c}}{T_{\rm c}} \right)^{-z\nu} \tag{1}$$

で表され、個々の磁気モーメントの緩和時間に 対応する τ_0 、磁気転移温度 T_c 、臨界指数zvが、それぞれ、 $\tau_0=2.1\times10^{-13}$ s、 $T_c=7.5$ K、zv=11と求まる。 τ_0 の値は一つの磁気モーメント の緩和時間としては妥当であり、臨界指数はイ ルメナイト型結晶のスピングラス (Mn, Fe) TiO₃ などと同等の値である。

図2は同じ組成のガラスのエージング・メモ リー効果を表している。図中の下部にある実線 はエージングを行っていない場合のゼロ磁場冷 却における直流磁化率の温度依存性であり,基 本的には図1のデータと同じ挙動である。一 方, ■で表された磁化率の温度依存性は5Kに おいて3hのエージングを行った場合の結果で ある。すなわち,磁場を加えない状態でガラス 試料を室温から冷却し,5Kにおいて3hの間 そのままの状態で保持(この過程をエージング とよぶ)したのち,さらに低温まで冷却して, そこで初めて直流磁場を印加し,昇温過程で磁 化率を測定している。5Kでの3hのエージン グの結果,磁化率はこの温度近傍でエージング を行わなかった場合と比べて減少している。図



図2 30Fe₂O₃・15FeO・55P₂O₅ (mol%) ガラスの エージング・メモリー効果

2の上部の実線は両者の磁化率の差をとったも のであり、5Kにおけるエージングの効果が明 確に見られる。つまり、試料のガラスの磁気構 造は、磁場など外部からの刺激がないにもかか わらず一定の温度で非常に長い時間をかけて変 化し、その変化は他の温度では磁気構造に反映 されない。一方で、この磁気構造の変化は、低 温まで試料の温度が下げられても(すなわち、 他の条件に移されても)、元の条件に戻せば(こ の場合は温度が5Kになれば)再び現れる。こ れをメモリー効果という。図2や上記の図1で 観察される現象は、30Fe₂O₃・15FeO・55P₂O₅ ガラスがスピングラス転移を起こしていること を明確に示している。

最近,結晶のスピングラスでは磁場に対する 安定性が実験に基づいて議論されている。イジ ング系スピングラスの無限レンジの平均場理論 である Sherrington-Kirkpatrick 模型 (SK 模 型)^{22),23)}では、de Almeida-Thouless 線(AT 線)²⁴⁾ とよばれる磁場と温度の関係を表す条件に対応 した状態になるまでは、スピングラスは磁場に 対して安定である(ちなみに,提唱者のD.J. Thouless は 2016 年のノーベル物理学賞を受賞 した)。 一方. Fisher と Huse が提案した液滴 模型²⁵⁾⁻²⁷⁾では、スピングラスは磁場に対して不 安定である。どちらの理論が実際のスピングラ スを正しく表現しているかを実験的に明らかに するための研究がいくつか行われているが、現 在のところ、それぞれの理論に従うスピングラ ス(つまり、磁場に対して安定なスピングラス と不安定なスピングラス)が存在するというの が結論である。たとえば、(*R*, Y)Ru₂Si₂(*R*=Dy, Tb. Gd) 合金結晶のスピングラス相は SK 模型 で合理的に説明できるが^{28), 29)},前出の(Mn, Fe) TiO₃では液滴模型が成り立つ^{30),31)}。換言する と、(R,Y)Ru₂Si₂ 合金は磁場に対して安定なス ピングラスであり、(Mn, Fe)TiO₃は磁場に対 して不安定なスピングラスである。

これまで,酸化物ガラスに対してこのような 考察はまったく行われていないため,筆者らは 50FeO・50P₂O₅ (mol%) ガラスを対象にスピ ングラス相の磁場中での安定性を実験的に調べ てみた。このガラスはFe²⁺のみを含むため. イジング系であると仮定できる。まず、直流磁 場を印加せずに交流磁化率の温度依存性を測定 したところ図1と同様の結果が得られ、スピン 凍結温度の交流周波数依存性を式(1)を用いて 解析すると、臨界指数としてzv=10.8が得ら れた。これは酸化物結晶のスピングラスで観察 される値と同等である。一方.0.1 Tの直流磁 場下で同様の測定を行い、やはり式(1)を用い て解析したところ, 臨界指数はzv=16.2とな った。この値はスピングラスで報告されている 値より大きく、このことから、50FeO・50P₂O₅ ガラスのスピングラス相は磁場に対して不安定 で. 磁場中では臨界減速を伴う相転移を示さな いことがわかる。そこで、次に液滴模型に基づ く解析を試みた。このとき、緩和時間とスピン 凍結温度との関係は、磁場Hと温度Tの比が 一定の条件下で.

$$\ln \frac{\tau}{\tau_0} \propto \Delta T_{\rm f}^{-(1+\nu_H \psi)} \tag{2}$$

と表される。ここで、 Δ は一つの液滴が消滅す る過程に対するエネルギー障壁であり、系の大 きさを考慮したものである。また、 v_{tt} と ψ は 臨界指数である。図3(a)は、一定の交流周波 数における直流磁場とスピン凍結温度との関係 を表したものであり、直線はH/T=0.21 T/K に対応する。測定データを結ぶ曲線とこの直線 との交点から読み取ったスピン凍結温度と緩和 時間との関係を式(2)に基づいて解析した結果 が図3(b)であり、解析から $v_{tt}\psi=0.40$ が得ら れる。さらに、臨界指数は

$$v_{H} = \frac{1}{d/2 - \theta} \tag{3}$$

と表現されることが知られている。ここで、dは系の次元であり、50FeO・50P₂O₅ ガラスの 場合、d=3である。また、 θ は液滴の励起に 必要なエネルギーと系の大きさを関係づける指 数であり、d=3のとき $\theta\approx 0.2$ であるため³², v_H



図3 (a)50FeO・50P₂O₅ (mol%) ガラスにおける直流磁場 H_{dc} とスピン凍結温度 T_i との関係. 各データ点を結 ぶそれぞれの線は異なる周波数 (左から右へ f=0.1,0.3,1,3,10,30,100,300,1000 Hz) に対応する. 直線 は H/T=0.21 T/K の関係を表す. (b) T_f^{-1.4} と lnr との関係.

は 0.8 になる。よって、 $\psi = 0.5$ となり、液滴 模型で導かれている関係 $\theta \le \psi \le d - 1^{27}$ を満た す。すなわち、50FeO・50P₂O₅ ガラスのスピ ングラス相は SK 模型よりもむしろ液滴模型で 説明することができる。このことは、このスピ ングラス相が磁場中では安定に存在できないこ とを示している。

3. おわりに

本稿では触れなかったが、NEW GLASS 誌 の解説²¹⁾および原著論文¹⁵⁾でも報告した通り、 EuO-TiO₂系アモルファス薄膜は温度が下がれ ばまず常磁性から強磁性に相転移し、さらに低 温でスピングラス相に転移する。すなわち、リ エントラントスピングラスとなる。この系は強 磁性を示すめずらしいアモルファス酸化物であ り、しかも磁気転移温度はアモルファス相の方 が同じ組成の結晶と同程度かむしろ高くなると いう、きわめて興味深い性質を有する。特に EuTiO₃ は結晶の安定相が反強磁性転移を示す のに対してアモルファス相は強磁性転移を示 す。この系に見られるリエントラントスピング ラスを含め、これまで述べてきたように酸化物 ガラス(アモルファス酸化物)は低温において 最終的にはスピングラス相になる傾向がある が,その本質を理解するにはまだ実験的解析が 不十分であると感じる。今後の展開に期待した い。

謝辞

本稿で述べた研究の結果は,筆者が所属する研 究室のスタッフ,学生,ならびに卒業生との共同 研究に基づくものであり,その観点から,京都大 学大学院工学研究科の藤田晃司准教授,村井俊介 助教,赤松寛文博士(現在,東京工業大学助教), 奥聡志氏,中塚祐子氏に感謝する。

参考文献

- 1) V. Cannella and J. A. Mydosh, *Phys. Rev. B* 6, 4220 (1972).
- 2) S. Nagata P. H. Keesom, and H. R. Harrison, *Phys. Rev. B* 19, 1633 (1979).
- 西森秀稔,スピングラス理論と情報統計力学,岩 波書店(2003).
- J. J. Hopfield, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 2554 (1982).
- 5) R. A. Verhelst, R. W. Kline, A. M. de Graaf, and H. O. Hooper, *Phys. Rev. B* 11, 4427 (1975).
- 6) J. P. Renard, J. P. Miranday, and F. Varret, *Solid State Commun.* 35, 41 (1980).

- 7) J. P. Sanchez and J. M. Friedt, *J. Physique* 43, 1707 (1982).
- P. Beauvillain, C. Dupas, J. P. Renard, and P. Veillet, *Phys. Rev. B* 29, 4086 (1984)
- J. P. Sanchez, J. M. Friedt, R. Horne, and A. J. Van Duyneveldt, *J. Phys. C* 17, 127 (1984)
- 10) P. Beauvillain, C. Chappert, J. P. Renard, and J. Seiden, *J. Magn. Magn. Mater.* 54–57, 127 (1986).
- 11) H. Akamatsu, K. Tanaka, K. Fujita, and S. Murai, *Phys. Rev. B* 74, 012411 (2006).
- 12) H. Akamatsu, K. Tanaka, K. Fujita, and S. Murai, J. Phys. : Condens. Matter 20, 235216 (2008).
- 13) H. Akamatsu, S. Oku, K. Fujita, S. Murai, and K. Tanaka, *Phys. Rev. B* 80, 134408 (2009).
- 14) H. Akamatsu, K. Fujita, S. Murai, and K. Tanaka, *Phys. Rev. B* 81, 014423 (2010).
- 15) H. Akamatsu, K. Fujita, Y. Zong, N. Takemoto, S. Murai, and K. Tanaka, *Phys. Rev. B* 82, 224403 (2010).
- 16) H. Akamatsu, J. Kawabata, K. Fujita, S. Murai, and K. Tanaka, *Phys. Rev. B* 84, 144408 (2011).
- 17) T. Kawamoto, K. Fujita, H. Akamatsu, T. Nakamura, T. Kinoshita, M. Mizumaki, N. Kawamura, M. Suzuki, Y. Kususe, S. Murai, and K. Tanaka, *Phys. Rev. B* 88, 024405 (2013).
- 18) Y. Nakatsuka, H. Akamatsu, S. Murai, K. Fujita, and K. Tanaka, *Jpn. J. Appl. Phys.* 53, 05 FB 11 (2014).
- 19) 田中勝久, NEW GLASS 20, 51 (2005).
- 20) 田中勝久, NEW GLASS 24, 47 (2009).

- 21) 田中勝久,藤田晃司,村井俊介,赤松寛文, Zong Yanhua, 竹本直紘, NEW GLASS 26, 26 (2011).
- 22) D. Sherrington and S. Kirkpatrick, *Phys. Rev. Lett.* 35, 1792 (1975).
- 23) S. Kirkpatrick and D. Sherrington, *Phys. Rev. B* 17, 4384 (1978).
- 24) J. R. L. de Almeida and D. J. Thouless, J. Phys. A. Math. Gen. 11, 983 (1978).
- 25) D. S. Fisher and D. A. Huse, *Phys. Rev. Lett.* 56, 1601 (1986).
- 26) D. S. Fisher and D. A. Huse, *Phys. Rev. B* 38, 373 (1988).
- 27) D. S. Fisher and D. A. Huse, *Phys. Rev. B* 38, 386 (1988).
- 28) Y. Tabata, K. Matsuda, S. Kanada, T. Yamazaki, T. Waki, H. Nakamura, K. Sato, and K. Kindo, J. *Phys. Soc. Jpn.* 79, 123704 (2010).
- 29) Y. Tabata, S. Kanada, T. Yamazaki, T. Waki, and H. Nakamura, J. Phys. Conf. Ser. 320, 012051 (2011).
- 30) J. Mattsson, T. Jonsson, P. Nordblad, H. Aruga Katori, and A. Ito, *Phys. Rev. Lett.* 74, 4305 (1995).
- 31) P. E. Jonsson, H. Takayama, H. Aruga Katori, and A. Ito, 2005 *Phys. Rev. B* 71, 180412 (R) (2005).
- 32) A. Bray and M. A. Moore, *J. Phys. C* 17, L 463 (1984).